

12 inch 4H-SiC 衬底规格书
12 Inch 4H-SiC Substrate Specifications

第 1 页 Page 共 2 页 Total

12 inch 4H-SiC 衬底规格书

等级 Grade	Production Grade
Diameter 直径	300.00 ± 0.5 mm
Thickness 厚度	400 ± 20 μm
Surface Orientation 晶向	4 °toward<11-20> ± 0.5°
定位边	Notch / 全圆
Notch Depth Notch 深度	1 ~ 1.5mm
Micropipe Density 微管密度	≤0.2 /cm ²
TTV 总厚度变化	≤10 μm
Surface Roughness 表面粗糙度	Si Face Ra≤ 5 nm, C Face Ra≤ 5 nm Si 面 Ra≤ 5 nm, C 面 Ra≤ 5 nm
Edge Chips 崩边	无深度>1mm 的崩边
Laser marking 打标	As per SEMI Standard 按照 SEMI 标准
Polytype Area by polarized light 偏振光检测多型	None permitted 无
Cracks by high-intensity light 强光灯检测裂纹	None permitted 无
Packaging	Single Wafer Container;